(19) 日本国特許庁 (JP)			(12) 特	許	公	報((B2)	(11) 特許都	昏号
<							/ 	特	許第6029115号 (P6029115)
(45) 発行日	平尾285	E11月24日 (2016.	11.24)				(24) 登録日	平成28年10月2	8日 (2016.10.28)
(51) Int.Cl.			FΙ						
GO2B	6/32	(2006.01)	C	GO2B	6/3	32			
GO2B	6/30	(2006.01)	C	GO2B	6/3	30			
GO2B	6/36	(200 6.01)	C	GO 2 B	6/3	36	301		
GO2B	6/122	(2006.01)	(GO 2 B	6/1	.22			
GO2B	6/13	(2006.01)	(GO 2 B	6/1	3			
								請求項の数	17 (全 23 頁)
(21) 出願番号	÷	特願2014-64218	(P2014-64)	218)	(73) 特	許権者	皆 39000953	31	
(22) 出願日		平成26年3月26日	(2014.3.)	26)			インターナ	-ショナル・ビジ	ネス・マシーン
(65) 公開番号	÷	特開2015-18466	7 (P2015-1	84667A)			ズ・コーオ	ペレーション	
(43) 公開日		平成27年10月22	日(2015.1	0.22)			INTER	RNATIONA	LBUSIN
審査請求日		平成28年1月5日	(2016.1.5))			ESSM	Í A C H I N E S	CORPOR
							ATION	I	
早期審査対象出願					アメリカ台	〒衆国10504	ニューヨーク		
							州 アーモ	シンク ニュー	オーチャード
							ロード		
							New C)rchard	Road, A
							rmonk	t, New Y	ork 105
							04, L	Inited S	tates o
					 (7 A) AI		t Ame	erica	
					(<i>1</i> 4) ft	理人	100108501		
							升理工 」	」到"刚丈	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光デバイス、光コネクタ・アセンブリおよび光接続方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

それぞれ反射面を有する複数の導波路が形成された基板と、

前記複数の導波路に面し、複数のレンズがそれぞれ対応する反射面各々に位置合わせさ れて設けられる導波路側レンズアレイを備えるレンズアレイ部と、

複数のレンズがそれぞれ対応する前記導波路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせ されて設けられる光伝送路側レンズアレイを備え、複数の光伝送路が挿入されそれぞれ対 応する前記光伝送路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせされて固定されるコネクタ 部であって、前記光伝送路側レンズアレイおよび前記導波路側レンズアレイが略平行に維 持されるように前記レンズアレイ部の上面に当接する底面を有する、コネクタ部と

10

20

を含み、前記基板および前記レンズアレイ部は、それぞれ、前記導波路側レンズアレイ のレンズ各々を対応する反射面各々に位置合わせする位置合わせ機構を構成する基板側部 分およびレンズアレイ側部分を含む、光デバイス。

【請求項2】

前記レンズアレイ側部分は、前記レンズアレイ部の底面の前記複数の導波路に面する領域の両側に設けられた少なくとも一対の矩形スタッドを含む、請求項<u>1</u>に記載の光デバイス。

【請求項3】

前記基板側部分は、前記一対の矩形スタッドにおける4つの長側面のうちの外側または 内側の2つと、前記一対の矩形スタッドのうちの一方にある1つの短側面と、他方にある 前記一方の短側面とは反対側の1つの短側面とを少なくとも受け止めるように前記基板の 表面に設けられた、一揃いの位置決め部材を含む、請求項<u>2</u>に記載の光デバイス。 【請求項4】

前記一揃いの位置決め部材は、前記矩形スタッドを嵌合させる矩形溝、前記矩形スタッ ドの1つの角を受け止めるL字部材、前記矩形スタッドの2つの角を受け止めるコの字部 材、またはこれらの組み合わせを含む、請求項<u>3</u>に記載の光デバイス。

【請求項5】

前記基板側部分は、前記導波路のコア材料を用いて形成される、請求項<u>1~4</u>のいずれ か1項に記載の光デバイス。

【請求項6】

10

20

前記レンズアレイ側部分は、前記レンズアレイ部の底面の前記複数の導波路に面する領 域の両側に設けられた少なくとも一対のテーパ形状を有する突起部を含み、前記基板側部 分は、前記突起部各々が挿入されるように前記基板の表面に設けられた一対の溝または穴 を含む、請求項1に記載の光デバイス。

【請求項7】

前記複数の導波路各々が有する反射面は、隣接する導波路間で軸方向に変位して設けられることで複数の列をなし、前記導波路側レンズアレイおよび前記光伝送路側レンズアレ イのレンズは、前記反射面がなす複数の列に対応して複数の列をなす、請求項1~<u>6</u>のい ずれか1項に記載の光デバイス。

【請求項8】

<u>前記レンズアレイ部は、</u>前記光伝送路側レンズアレイのレンズ各々が対応する前記導波 路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせされるように前記コネクタ部を支持するホル ダ部<u>を含む、</u>請求項1~<u>7</u>のいずれか1項に記載の光デバイス。

【請求項9】

前記レンズアレイ部および前記ホルダ部が一体形成され、前記ホルダ部および前記コネ クタ部は、それぞれ、前記光伝送路側レンズアレイを位置合わせする位置合わせ機構を構 成するホルダ側部分およびコネクタ側部分を含み、該位置合わせ機構により、前記光伝送 路側レンズアレイのレンズ各々が、対応する前記導波路側レンズアレイのレンズ各々と位 置合わせされる、請求項<u>8</u>に記載の光デバイス。

【請求項10】

それぞれ前記レンズアレイ部および前記コネクタ部が結合された複数の光コネクタ・ア センブリを前記基板に対して固定するとともにそれぞれアセンブリ毎の光伝送路を挿通す る複数の開口を有する固定治具をさらに含む、請求項1~<u>9</u>のいずれか1項に記載の光デ バイス。

【請求項11】

前記レンズアレイ部は、所定波長の光を透過する樹脂で形成されており、前記光デバイ スは、前記複数の導波路が形成される導波路層の表面に前記反射面の箇所を挟んで形成さ れたリセス部を備え、前記レンズアレイ部の底面と前記導波路層とを接着する光硬化性接 着層をさらに含む、請求項1~<u>10</u>のいずれか1項に記載の光デバイス。

【請求項12】

基板上のそれぞれ反射面を有する複数の導波路に面して設けられ、複数のレンズがそれ ぞれ対応する反射面各々に位置合わせされて設けられる導波路側レンズアレイを備えるレ ンズアレイ部と、

複数のレンズがそれぞれ対応する前記導波路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせ されて設けられる光伝送路側レンズアレイを備え、挿入された複数の光伝送路をそれぞれ 対応する前記光伝送路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせして固定するコネクタ部 であって、前記光伝送路側レンズアレイおよび前記導波路側レンズアレイが略平行に維持 されるように前記レンズアレイ部の上面に当接する底面を有する、コネクタ部と

を含み、前記レンズアレイ部は、前記導波路側レンズアレイのレンズ各々が対応する反 射面各々に位置合わせされるように前記基板に対して位置合わせする位置合わせ機構のレ 30

40

ンズアレイ側部分を底面に有する、光コネクタ・アセンブリ。

【請求項13】

前記位置合わせ機構を構成する前記レンズアレイ側部分は、前記レンズアレイ部の底面 の前記複数の導波路に面する領域の両側に設けられた少なくとも一対の矩形スタッドまた はテーパ形状を有する突起部を含む、請求項<u>12</u>に記載の光コネクタ・アセンブリ。 【請求項14】

(3)

<u>前記レンズアレイ部は、</u>前記光伝送路側レンズアレイのレンズ各々が対応する前記導波 路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせされるように前記コネクタ部を支持するホル ダ部をさらに含み、

前記ホルダ部は、前記レンズアレイ部と一体形成され、前記コネクタ部に結合する結合 ¹⁰ 部が設けられる<u>、</u>請求項<u>12</u>または<u>13</u>に記載の光コネクタ・アセンブリ。

【請求項15】

光接続を行う方法であって、

それぞれ反射面を有する複数の導波路が形成された基板を準備する工程と、

前記複数の導波路に面し、複数のレンズが設けられる導波路側レンズアレイを備えるレ ンズアレイ部を、前記導波路側レンズアレイのレンズ各々が対応する反射面各々に位置合 わせされるように、前記基板上に配置する工程と、

複数のレンズが設けられる光伝送路側レンズアレイを備え、複数の光伝送路が挿入され それぞれ対応する前記光伝送路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせされて固定され るコネクタ部を、前記光伝送路側レンズアレイのレンズ各々が対応する前記導波路側レン ズアレイのレンズ各々に位置合わせされるように、前記レンズアレイ部に対し取り付ける 工程であって、前記光伝送路側レンズアレイおよび前記導波路側レンズアレイが略平行に 維持されるように前記コネクタ部の底面が前記レンズアレイ部の上面に当接する、当該取 り付ける工程と

を含み、

<u>前記基板を準備する工程は、前記導波路側レンズアレイを位置合わせする位置合わせ機</u> 構を構成する基板側部分を形成する工程を含み、

前記基板上に配置する工程は、前記レンズアレイ部の底面に設けられた前記位置合わせ 機構を構成するレンズアレイ側部分を、前記基板の前記基板側部分に対して位置決めする 工程を含む、光接続方法。

【請求項16】

前記基板側部分を形成する工程は、

前記基板上の導波路層を構成するコア層をパターニングすることによって、前記複数の 導波路を形成するとともに、前記基板側部分を形成する工程と、

前記基板側部分を露出し、パターニングされた前記複数の導波路のコア層を覆う上部クラッド層を形成する工程と

を含む、請求項15に記載の光接続方法。

【請求項17】

前記基板を準備する工程は、前記複数の導波路が形成される導波路層の表面に前記反射 面の箇所を挟んでリセスを形成する工程と、

前記基板の導波路層の表面に光硬化性接着剤を塗布する工程と

を含み、前記光接続方法は、

前記基板上に配置する工程後、前記基板上に配置された前記レンズアレイ部を通して光 を照射し、前記光硬化性接着剤を硬化させて、前記レンズアレイ部の底面と前記導波路層

とを接着する工程

をさらに含む、請求項15または16に記載の光接続方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、基板に導波路を備える光デバイスに関し、より詳細には、基板の導波路を外 50

20

部の光伝送路に接続することができる光デバイス、基板の導波路と外部の光伝送路とを接 続するための光コネクタ・アセンブリおよび光接続方法に関する。

【背景技術】

【 0 0 0 2 】

近年、光インターコネクト技術における消費電力の削減および高速化に対する要求がま すます高まっている。消費電力の削減および高速化を同時に実現するため、光電気変換部 の低電力化および高速化が進められるとともに、実装基板上での光信号の入出力部を半導 体回路チップに対しより近接して設けた光マルチ・チップ・モジュール(光MCM:Opti cal Multi Chip Module)の開発が進められている。

[0003]

上述した光MCMの光配線は、外部の光配線回路に対し、光ファイバなどの光伝送路を 介して低損失に接続することが求められる。従来技術では、光MCMの基板の側面部に設 けた光コネクタを介して基板上の導波路と光ファイバとを接続する手法が用いられていた 。図18は、従来技術における光MCMおよび光ファイバの接続構造を示す図である。図 18(A)は、側面図を示し、図18(B)は、上面図を示す。

【 0 0 0 4 】

図18に示す光MCM500において、有機基板502の表面には、基板端部から、搭載された半導体チップ520に近接する位置まで、導波路層510が形成されている。導波路層510各々には、コアを伝送してきた光を上方に向けて偏向し、または、上方からきた光をコア内に偏向する45°ミラー512が形成されている。導波路層510上のミラー512に対応する位置には、送信側ではVCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting LASER)528が設けられ、受信側ではフォトダイオード(PD:Photo Diode)526が設けられ、これらはアンダーフィル516により固定されている。

【 0 0 0 5 】

有機基板502上には、PD526からの電気信号を増幅するTIA/LIA(Transl mpedance Amplifier / LImiting Amplifier) 522と、VCSEL528を駆動するL DD(Laser Diode Driver) 524とが設けられる。TIA/LIA522、LDD52 4、PD526およびVCSEL528は、ビア514を介して有機基板502に形成された電気配線506に接続される。また、有機基板502の基板端面には、光コネクタ5 40が設けられており、光コネクタ540を介してファイバ・リボン530と導波路層5 10とが接続される。

[0006]

光ファイバと導波路との光インターコネクト技術に関しては、その他、特開2004-191565号公報(特許文献1)が知られている。特許文献1は、束ねられた光ファイ バと、1次元的または2次元的に配列された光導波路または光電変換素子とを備え、被位 置決め部材を有する外部部品に光接続される光路変換コネクタを開示する。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0007]

【特許文献1】特開2004-191565号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながら、今後、ますます高いバンド幅が求められ、チャネル数が増加するに伴い 、図18に示すような従来技術の光コネクタでは、有機基板502の基板側面で光ファイ バ接続を行っているため、多チャンネル化に困難があった。基板側面で接続を得る構造で は、基板厚さに制約があり、接続に利用可能な面積が限定され、光接続の構造が相対的に 大きくなってしまうためである。また、低損失な光接続を実現するための光コネクタの位 置合わせ公差を緩和することが望まれていた。上述した特許文献1に開示される光路変換 コネクタも、高バンド幅化および多チャネル数化に充分に対応できるものはなかった。 10

20

[0009]

本発明は、上記従来技術における不充分な点に鑑みてなされたものであり、本発明は、 基板上に形成された複数の導波路を外部の光伝送路に対し接続する光接続構造の空間的制 約を緩和し、位置合わせ公差を緩和することができる、光デバイス、光コネクタ・アセン ブリおよび光接続方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明では、下記特徴を有する光デバイスを提供する。本 光デバイスは、それぞれ反射面を有する複数の導波路が形成された基板と、レンズアレイ 部と、コネクタ部とを含む。上記レンズアレイ部は、上記複数の導波路に面し、複数のレ ンズがそれぞれ対応する反射面各々に位置合わせされて設けられる導波路側レンズアレイ を備える。上記コネクタ部は、上記複数のレンズがそれぞれ対応する導波路側レンズアレ イのレンズ各々に位置合わせされて設けられる光伝送路側レンズアレイを備え、複数の光 伝送路が、挿入されそれぞれ対応する光伝送路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせ されて固定される。

[0011]

本発明では、また、上記導波路側レンズアレイを備えるレンズアレイ部と、光伝送路側 レンズアレイを備え、挿入された複数の光伝送路をそれぞれ対応する光伝送路側レンズア レイのレンズ各々に位置合わせして固定するコネクタ部とを含む、光コネクタ・アセンブ リを提供することができる。上記レンズアレイ部は、導波路側レンズアレイのレンズ各々 が対応する反射面各々に位置合わせされるように基板に対して位置合わせする位置合わせ 機構のレンズアレイ側部分を底面に有する。

【0012】

本発明では、さらに、下記特徴を有する光接続方法を提供することができる。本光接続 方法は、それぞれ反射面を有する複数の導波路が形成された基板を準備する工程と、導波 路側レンズアレイを備えるレンズアレイ部を、導波路側レンズアレイのレンズ各々が対応 する反射面各々に位置合わせされるように基板上に配置する工程と、複数のレンズが設け られる光伝送路側レンズアレイを備え、複数の光伝送路が挿入されそれぞれ対応する光伝 送路側レンズアレイのレンズ各々に位置合わせされて固定されるコネクタ部を、上記光伝 送路側レンズアレイのレンズ各々が対応する導波路側レンズアレイのレンズ各々に位置合 わせされるように、レンズアレイ部に対し取り付ける工程とを含む。

30

20

10

【発明の効果】 【0013】

上記構成により、基板上に形成された複数の導波路を外部の光伝送路に対し接続する光 接続構造の空間的制約を緩和し、位置合わせ公差を緩和することができる。

【図面の簡単な説明】

【0014】

【図1】本発明の第1の実施形態による光マルチ・チップ・モジュールの構造および、光 マルチ・チップ・モジュールと光ファイバとの間の接続構造を模式的に示す図。

【図2】本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリが取り付けられる、基板 ⁴⁰ 上に形成された導波路を示す図。

【図3】本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリの構造を示す図。

【図4】本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリおよび対応する基板の構造を示す図。

【図 5】本発明の第 1 の実施形態による光コネクタ・アセンブリを基板へ取り付ける光接 続方法を説明する図(1 / 2)。

【図6】本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリを基板へ取り付ける光接 続方法を説明する図(2/2)。

【図7】好適な実施形態による導波路コアおよびダミーコアの形成方法を説明する図。

【図8】本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリが取り付けられる基板の 50

他の構造を例示する図。

【図9】本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリが取り付けられる基板の さらに他の構造を例示する図。

【図10】4列にレンズが配列された基板側コンポーネントを示す上面図。

【図11】光コネクタ・アセンブリを基板に固定する簡易な固定方法を示す図。

【図12】光コネクタ・アセンブリを基板に固定する改良された固定方法を示す図。

【図13】図12に示す改良された固定方法で用いることができる、溝およびリセスを形 成するための2種類のマスクパターンを示す図。

【図14】光コネクタ・アセンブリを構成するファイバ・コネクタを基板に固定する固定 治具を示す図。

【図15】光コネクタ・アセンブリを構成するファイバ・コネクタを基板に固定する他の 固定治具を示す図。

【図16】本発明の第2の実施形態による光マルチ・チップ・モジュールと光ファイバ・ リボンとの間の接続構造を模式的に示す図(1/2)。

【図17】本発明の第2の実施形態による光マルチ・チップ・モジュールと光ファイバ・ リボンとの間の接続構造を模式的に示す図(2/2)。

【図18】従来技術における光マルチ・チップ・モジュールおよび光ファイバの接続構造 を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0015】

20

40

50

10

以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照しながら説明するが、本発明は、 添付の図面に示す実施形態に限定されるものではない。なお、添付の図面は、縮尺比に従 って縮小または拡大されたものではないことに留意されたい。

【0016】

[第1の実施形態]

以下、本発明の第1の実施形態による光デバイスおよび光コネクタ・アセンブリについて、光マルチ・チップ・モジュール100および光コネクタ・アセンブリ132を一例として説明する。

【0017】

図1は、本発明の第1の実施形態による光マルチ・チップ・モジュール(以下、光MC 30 Mと参照する。)100の構造、および、光MCM100と光ファイバ・リボン130と の間の接続構造を模式的に示す。図1(A)は、側面図を示し、図1(B)は、上面図を 示す。

[0018]

光MCM100は、基板102上に、それぞれ電気的な論理回路を備える1以上の半導体チップ120を備える。基板102の表面には、半導体チップ120に近接する位置まで延びる導波路層110が形成されている。導波路層110は、1次元的または2次元的に配列された複数の導波路を含み構成される。導波路層110を設け、半導体チップ12 0に可能な限り近接した箇所まで光信号として信号を伝達することによって、実装基板上での電気信号の伝送距離の短縮が図られている。信号の変調周波数が高くなると、電気信号では信号の歪みが大きく熱として消失してしまうからである。

【0019】

導波路層110は、典型的には、ポリマー導波路として構成される。導波路層110の コア材およびクラッド材としては、ポリイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリカー ボネート系樹脂、ポリアミド系樹脂、シリコーン樹脂、ポリウレタン系樹脂、アクリレー ト系樹脂、ポリシロキサン系樹脂、フェノール系樹脂、ポリキノリン系樹脂などの種々の 樹脂が挙げられる。

【0020】

導波路を伝送する光信号および半導体チップ120で扱われる電気信号間の光電変換は、フォトダイオード(PD)126および垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)128

(6)

によって行われる。導波路層110の導波路各々の一方の端部には、45°傾斜の反射面 112が形成されており、PD126およびVCSEL128は、導波路が有する反射面 112の位置に設けられ、アンダーフィル116により固定される。反射面112は、そ れぞれ、導波路を伝送してきた光を上方のPD126の受光領域に向けて偏向し、または 、上方のVCSEL128から放出された光を導波路に入射するように偏向する。 【0021】

PD126からの電気信号は、TIA/LIA122で増幅される。VCSEL128 は、LDD124によって駆動される。TIA/LIA122、LDD124、PD12 6およびVCSEL128は、ビア114を介して基板102に形成された多層の電気配 線106に接続される。基板102の裏面には、電気入出力部104が設けられており、 光MCM100は、図示しないマザーボードに電気的に接続される。

【0022】

導波路層110の導波路各々の他方の端部にも、45°傾斜の反射面118が形成され ており、導波路の光路を基板垂直方向へ偏向するよう構成されている。そして、基板10 2上面の導波路層110の反射面118の位置に、光コネクタ・アセンブリ132が設け られている。

【0023】

本発明の実施形態による光MCM100は、基板102の表面に形成された導波路層1 10と光ファイバ・リボン130とを光接続する光コネクタ・アセンブリ132を、基板 上面に備えていることを特徴としている。第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリ 132は、基板102上の反射面118の領域に面して位置決めして設置される基板側コ ンポーネント140と、光ファイバ・リボン130が挿入および固定されて、基板側コン ポーネント140に対し取り付けられるファイバ・コネクタ150とを含み構成され、こ れらの双方にマイクロレンズアレイを付属させた、上方アクセス型のコネクタ構造を有す る。基板側コンポーネント140およびファイバ・コネクタ150は、それぞれ、第10 実施形態におけるレンズアレイ部およびコネクタ部を構成する。

【0024】

上記基板側コンポーネント140に付属するマイクロレンズアレイは、複数のマイクロレンズを備える。基板側コンポーネント140は、付属するマイクロレンズ各々が導波路 各々に形成された反射面各々に位置合わせされるように基板102上に位置決め設置される。ファイバ・コネクタ150に付属するマイクロレンズアレイも同様に複数のマイクロレンズを備える。ファイバ・コネクタ150は、付属するマイクロレンズ各々が上記基板 側コンポーネント140のマイクロレンズ各々に位置合わせされるように取り付けられる

[0025]

本発明の第1の実施形態による光MCM100では、基板上面で上方から光ファイバを 接続する構成とすることで、基板側面で接続する場合と比較した空間的な制約の緩和を図 っている。同時に、双方のマイクロレンズアレイを介して導波路および光ファイバ間を結 合する構成とすることで、導波路および光ファイバ間の位置合わせ公差の緩和を図ってい る。

【0026】

以下、図2~図6を参照しながら、本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセン ブリ132を用いた光接続構造について、より詳細に説明する。図2は、本発明の第1の 実施形態による光コネクタ・アセンブリ132が取り付けられる、基板102に形成され た導波路層110を示す上面図である。図2(A)は、2列にレンズが配列されたマイク ロレンズアレイを用いる場合の導波路を示し、図2(B)は、4列にレンズが配列された マイクロレンズアレイを用いる場合の導波路を示す。以下、まず、図2(A)および図3 ~図6を参照しながら、マイクロレンズレンズおよび導波路の反射面を2列に配列する実 施形態について説明する。

[0027]

50

40

10

20

図2(A)に示すように、説明する実施形態では、導波路層110において、複数の導 波路WGが基板水平方向に沿って設けられている。導波路WG各々には、45°の傾斜を 有する反射面Mが形成されている。この反射面Mに合わせて、光ファイバFが位置決めさ れる。

【0028】

1000BASE-SX、LXなどの標準的な規格では、光ファイバのクラッド径は、 直径約125µmであり、コア径は、マルチモードファイバの場合で約50µmまたは約 62.5µmであり、シングルモードファイバの場合で約9.2µmである。また、光フ ァイバFのピッチは、標準規格では、250µmが一般的である。一方、導波路のコアは 、典型的には、マルチモードで30~50µm角、シングルモード導波路で2~8µm角 のものが用いられている。

【0029】

このように、導波路WGは、光ファイバFよりも小さい寸法で形成することができるが 、光ファイバは、標準的な規格によってサイズが定められている。このため、基板側面で 接続するような構造では、光ファイバより狭いピッチ間隔で導波路を形成することが空間 制約上難しく、多チャンネル化および高密度化の障壁となる。

【 0 0 3 0 】

そこで、本実施形態による光接続構造では、上述したように上方アクセス型とし、広い 基板面を活用して、複数の導波路WG各々が有する反射面Mを、図2に示すように、隣接 する導波路間で軸方向に変位させて複数の列をなすように設ける構成を採用する。マイク ロレンズアレイも、反射面Mの配列に対応して、複数の列をなすように形成される。 【0031】

20

30

40

10

図2(A)に示す実施形態では、反射面Mは、導波路WGの配列において交互に位置を ずらして形成されており、2列に構成されている。導波路WGの軸方向における変位量は 、典型的には、1列分のファイバ・リボンやマイクロレンズ同士が重なり合わない距離と することができる。

[0032]

このように、反射面Mを交互に位置をずらして複数列で配列させることにより、各列で の光ファイバピッチの規格を満たすようにしながら、隣接する導波路間のピッチ間隔を、 光ファイバのピッチ間隔を列数で割った長さまで狭ピッチ化することができる。ひいては 、導波路を一列に並べその端面でファイバと接続する場合に比較して、導波路を高密度に 実装することが可能となる。例えば、標準規格上ファイバピッチが250μmに定められ ているのであれば、反射面の配列を2列とすることにより、125μmまで狭ピッチ化す ることができる。

【0033】

なお、説明する実施形態では、説明の便宜上、基板水平方向に一列に導波路WGが配列 された場合について説明するが、導波路WGの配列は、これに限定されるものではない。 他の実施形態では、ポリマー導波路を積層することにより、基板垂直方向を含む2次元的 に配列された導波路としてもよい。

【0034】

図3は、本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリ132の構造を示す。 図3(A)は、光コネクタ・アセンブリ132を構成する上部側のファイバ・コネクタ1 50の底面図を示す。図3(C)は、光コネクタ・アセンブリ132を構成する基板側コ ンポーネント140の上面図を示す。図3(B)は、ファイバ・コネクタ150および基 板側コンポーネント140の側面図を示す。なお、図3(B)は、概ねファイバ・コネク タ150および基板側コンポーネント140を中央(図3(A)および(C)において矢 印Aで示す。)で切断した断面図を表しているが、中央の前後に設けられるマイクロレン ズ144,154が模式的に図示されている点に留意されたい。

[0035]

図 3 に示すファイバ・コネクタ 1 5 0 は、上述した反射面 M の 2 次元配列に対応して 2 50

列にマイクロレンズ154が配列されたマイクロレンズアレイ152を備える。基板側コ ンポーネント140も、上述した反射面Mの2次元配列に対応して2列にマイクロレンズ 144が配列されたマイクロレンズアレイ142を備える。以下、ファイバ・コネクタ1 50に付属するマイクロレンズアレイを、ファイバ側マイクロレンズアレイ152と参照 し、基板側コンポーネント140に付属するマイクロレンズアレイを、導波路側マイクロ レンズアレイ142と参照する。

[0036]

ファイバ側マイクロレンズアレイ152は、ファイバ・コネクタ150の底面150a に設けられたくぼみ150b内に形成されている。導波路側マイクロレンズアレイ142 も、基板側コンポーネント140の上面140aに設けられたくぼみ140b内に形成さ れている。図示しないが、ファイバ・コネクタ150の上面からは、光ファイバ・リボン 130が挿入され、それぞれの端面が、対応するファイバ側マイクロレンズアレイ152 のマイクロレンズ154各々に位置合わせされて固定される。

[0037]

好適な実施形態では、基板側コンポーネント140およびファイバ・コネクタ150は 、さらに、ファイバ側マイクロレンズアレイ152を導波路側マイクロレンズアレイ14 2に対し位置合わせするための位置合わせ機構を含むことができる。

[0038]

説明する実施形態では、ファイバ・コネクタ150側の位置合わせ機構の部分として、 ファイバ・コネクタ150の底面150aにおけるファイバ側マイクロレンズアレイ15 2の両側の箇所に、一対の棒状スタッド156L,156Rが形成されている。棒状スタ ッド156L,156Rは、例えば円柱あるいは角柱として作成される。

20

10

[0039]

基板側コンポーネント140側の位置合わせ機構の部分としては、基板側コンポーネン ト140の上面140aにおける導波路側マイクロレンズアレイ142の箇所の両側に、 それぞれ棒状スタッド156L、156Rを嵌合する一対の穴または溝146L、146 Rが形成されている。なお、穴は、反対側まで貫通する空間を表し、溝は、反対側まで貫 通していないくぼみの空間を表すが、本実施形態において、両者は代替可能である。 [0040]

30 図4は、本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリ132および対応する 基板102の構造を示す。図4(A)は、基板側コンポーネント140の上面図を示し、 図 4 (C) は、基板 1 0 2 の上面図を示す。図 4 (B) は、基板側コンポーネント 1 4 0 および基板102の側面図を示す。図4(B)は、同様に、概ね基板側コンポーネント1 40および基板102を中央(矢印Aで図示する。)で切断した断面図を表しているが、 中央の前後に設けられるマイクロレンズ144および後述するダミーコア170が模式的 に図示されている点に留意されたい。また、図4(A)には、点線で、基板側コンポーネ ント140の底面140cに設けられる構造が示されている。

[0041]

本発明の第1の実施形態による基板側コンポーネント140および基板102は、導波 40 路側マイクロレンズアレイ142のマイクロレンズ144各々を導波路層110の導波路 各々が有する反射面M各々に対し位置合わせするための位置合わせ機構をさらに含む。説 明する実施形態では、図4に示すように、基板側コンポーネント140の位置合わせ機構 を構成する部分として、底面140cにおいて、導波路側マイクロレンズアレイ142が 形成された部分に対応する領域の両側に、一対の細長の矩形スタッド148L,148R が形成されている。

[0042]

基板102の位置合わせ機構を構成する部分としては、導波路の配列168の反射面の 配列176が形成された領域の両側に設けられた、上記一対の細長の矩形スタッド148 L,148Rを受け止める、一揃いの位置決め部材170L,170Rが形成されている

[0043]

図4(B)および図4(C)に示すように、基板102上の下部クラッド層160上に 複数のコア164が形成され、各コア164が、上部クラッド層166により覆われてい る。下部クラッド層160、コア164および上部クラッド層166によって、上述した 導波路の配列168が構成される。導波路の配列168には、さらに、45°傾斜の反射 面Mの配列176が形成される。

(10)

【0044】

導波路の配列168が形成された領域の両脇では、上部クラッド層166が除去され、 溝172L,172Rが切られており、下部クラッド層160およびダミーコア170L ,170Rが露出されている。ダミーコア170L,170Rは、コア材料を用いて、導 波路のコア164と同時にパターニングされた構造であり、コア164に対して高精度に 位置決めされて形成されている。このため、ダミーコア170L,170Rは、マイクロ レンズアレイ142を導波路のコア164の反射面Mに位置合わせする際の水平方向およ び垂直方向における良好な位置基準点を与えることができる。

【0045】

図4(C)に示すダミーコア170L,170Rは、それぞれ、L字形状を有しており、第1の実施形態においては、対角の関係にある2つのL字型のダミーコア170L,1 70Rが、上述した一揃いの位置決め部材を構成する。図4(C)には、破線174L, 174Rにより、上記一対の細長の矩形スタッド148L,148Rが位置決めされる下 部クラッド層160上の位置が表されている。一対のダミーコア170L,170Rは、 この位置に配置された矩形スタッド148L,148Rの角を受け止めて、基板水平方向 において矩形スタッド148L,148Rの位置がずれないよう固定する。

20

10

[0046]

図5および図6は、本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリ132を基 板102へ取り付ける光接続方法を説明する図である。図5は、正面から見た様子を示し 、図6は、側方から見た様子を示す。なお、図6には、紙面左側のマイクロレンズの列に 対応する反射面Mが図示され、一対の矩形スタッド148が配置される位置が破線174 で示され、点線でダミーコア170の位置も示されている。また、基板側コンポーネント 140およびファイバ・コネクタ150間の位置合わせ機構146,156も点線で示さ れている。

【0047】

光コネクタ・アセンブリ132を用いた光接続方法では、まず、第1の工程では、それ ぞれ反射面Mを有する導波路のコア164が形成された基板102が準備される。続いて 、第2の工程では、導波路側マイクロレンズアレイ142を備える基板側コンポーネント 140を基板102上に配置し、取り付ける。上述したように、基板102および基板側 コンポーネント140には、位置合わせ機構を構成する各部分が形成されている。基板側 コンポーネント140の基板102への配置は、基板側コンポーネント140の底面14 0cに設けられた一対の矩形スタッド148L,148Rを、基板102の一対のダミー コア170L,170Rに対して位置決めすることを含む。

[0048]

基板側コンポーネント140が基板102に取り付けられると、上記一対の矩形スタッド148L,148Rが基板102上の上記一対のL字のダミーコア170L,170R に受け止められ、その底部が下部クラッド層160の上面に当接する。これにより、導波 路側マイクロレンズアレイ142のマイクロレンズ144各々が、対応する導波路WGの 反射面M各々に、平行を維持し、かつ、水平方向に位置合わせされる。また、この際、典 型的には、ダミーコア170L,170Rの周辺や導波路層110の上面に接着剤を塗布 しておき、基板側コンポーネント140を基板102に接着することができる。 【0049】

続いて、第3の工程では、光ファイバ・リボン130が挿入および固定されたファイバ ・コネクタ150を基板側コンポーネント140に対し取り付ける。ファイバ・コネクタ

30

150が基板側コンポーネント140に取り付けられると、上記一対の棒状スタッド15 6L,156Rと上記一対の穴または溝146L,146Rとが嵌合し、さらに、ファイ バ・コネクタ150の底面150aおよび基板側コンポーネント140の上面140aが 当接する。これにより、ファイバ側マイクロレンズアレイ152のマイクロレンズ154 各々が、対応する導波路側マイクロレンズアレイ142のマイクロレンズ144各々に対 向して、平行を維持し、かつ、水平方向に位置合わせされる。棒状スタッド156L,1 56Rおよび穴または溝146L,146Rは、典型的には、挿抜可能に構成される。 【0050】

上述した構成を採用することにより、導波路WGと光ファイバF間の位置合わせの公差 を、導波路WGおよび光ファイバFを直接位置合わせする場合と比較して、10倍程度ま で好適に緩和することができる。そして、導波路WGが形成された基板102に対して、 基板側コンポーネント140を設計通りの位置に配置および固定し、基板側コンポーネン ト140に対してファイバ・コネクタ150を取り付けることで、導波路WGと光ファイ バFとの低損失な接続を簡便に実現することができる。

【0051】

以下、図7を参照しながら、好適な実施形態において位置合わせ機構を構成する基板側 位置合わせ部材であるダミーコアを導波路とともに形成する方法について説明する。図7 は、好適な実施形態による導波路コアおよびダミーコアの形成方法を説明する図であり、 図7(A)~(E)は、それぞれ、当該形成方法における各工程の基板の断面図を示す。 【0052】

図7に示す導波路およびダミーコアの形成方法では、第1の工程では、基板200上に 下部クラッド層202を形成する(図7(A))。続いて、第2の工程では、基板200 上の下部クラッド層202の上にコア層204を塗布する(図7(B))。第3の工程で は、フォトリソグラフィ法により、コア層204をパターニングし、導波路コアの配列2 04aと、L字型のダミーコア204bとを下部クラッド層202上に形成する(図7(C))。導波路コアの配列204aおよびL字型のダミーコア204bは、同じマスクパ ターンを用いて形成される。

[0053]

第4の工程では、コア層204を覆うように上部クラッド層206を塗布する(図7(D))。第5の工程では、フォトリソグラフィ法により、上部クラッド層206をパター ニングし、ダミーコア214周辺に溝212を有し、ダミーコア214および下部クラッ ド層202が露出するとともに、パターニングされた導波路のコアの配列210を覆う上 部クラッド層206を形成する(図7(E))。

[0054]

このように、好適な実施形態では、ダミーコア214は、導波路コアの配列210とと もに同ーマスクを用いて同一工程でパターニングされた構造として形成される。このため 、ダミーコア214は、導波路コアの配列210に対し高精度な水平方向および垂直方向 における位置基準点を与える。導波路コアの配列210およびダミーコア214を別々の 工程で作成することを妨げるものではないが、同一の工程で同時に作成することにより、 複数のマスクパターンの重ね合わせによる位置合わせ精度の劣化を好適に防止することが できる。また、コア層は、クラッド層に比較して精度高くパターニングすることができる ポリマー材料が知られており、リソグラフィ法を用いることにより、ダミーコア214を 高い寸法精度で加工することができる。

[0055]

なお、コアのパターニング方法は、特に限定されるものではない。例えば、塗布したコ ア層の上にフォトマスクを配置して露光し、現像することで、パターニングされたコア層 を形成する直接露光方式、フォトリソグラフィ法でフォトレジストのパターンをコア層上 に形成し、反応性イオンエッチング(RIE)などのエッチング処理を施し、パターニン グされたコア層を形成するRIE法、コア形状を有する金型を用いてクラッド層にコア形 状を複製し、形成されたコア形状の溝にコア材を注入することでパターニングされたコア 20

10

【 0 0 5 6 】

また、導波路WGの経路中に形成される45。傾斜の反射面Mは、例えば、ダイシング 加工やレーザ加工により、コアの光軸および基板上面に対し垂直な端面と、45。傾斜角 を有する反射面Mとを切り出すことにより形成することができる。反射面Mには、さらに 金やアルミニウムなどがマスク蒸着される。なお、反射面Mの形成方法は、特に限定され るものではなく、これまで既知の如何なる加工方法を用いて作成することができる。 【0057】

(12)

上述したファイバ・コネクタ150および基板側コンポーネント140の作成方法としては、特に限定されるものではないが、好ましい実施形態では、金型からポリマーへの転¹⁰ 写などの方法により、高い寸法精度で一体形成することができる。ファイバ・コネクタ1 50および基板側コンポーネント140の材料は、特に限定されるものではないが、光透 過性のポリマー材料を用いることができる。例示すると、上記導波路層について説明した ような、ポリイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリカーボネート系樹脂などの種々 の樹脂が挙げられる。

[0058]

以下、図8および図9を参照しながら、光コネクタ・アセンブリ132が取り付けられる基板102の構造の他の実施形態について説明する。

【 0 0 5 9 】

上述した第1の実施形態では、基板102の位置合わせ機構を構成する部分として、図 20 4に示すように、一対の細長の矩形スタッド148L,148Rの角を受け止める一対の L字型のダミーコア170L,170Rを形成した。この一対のL字型のダミーコア17 0L,170Rは、一対の矩形スタッド148L,148Rそれぞれにおける2箇所の外 側の角を含む4つの角に対して、対角線の関係にある2つの角からなる2組の角対のうち の1組の角対のそれぞれの角を受け止めるように形成されている。しかしながら、図4に 示した位置決め部材の形状は例示であり、これに特に限定されるものではない。

【0060】

ー般化すると、好ましい実施形態では、基板102側に形成される位置合わせ部分は、 上記ー対の矩形スタッド148における4つの長側面のうちの外側または内側の2つと、 ー対の矩形スタッドのうちの一方にある1つの短側面と、他方にある反対側の1つの短側 面とを少なくとも受け止めるように形成することができる。上記一揃いの位置決め部材は 、細長の矩形スタッドを嵌合させる矩形溝、矩形スタッドの1つの角を受け止めるL字部 材、矩形スタッドの2つの角を受け止めるコの字部材、またはこれらの組み合わせを含む ことができる。

[0061]

図8および図9は、本発明の第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリ132が取り付けられる基板102の他の構造を例示する図である。

【0062】

図8(A)および図8(B)は、L字型のダミーコア170L,170Rに代えて、上 部クラッド層166に溝180L,180Rが形成された基板を例示する。溝180L, 180Rは、一対の細長の矩形スタッド148R,148Lをちょうど嵌合させる寸法で 形成されている。溝180L,180Rは、フォトリソグラフィ法で形成してもよいし、 レーザ加工により形成してもよい。図8(C)および図8(D)は、リソグラフィ法によ り、コア材料を用いて、矩形スタッド148R,148Lを嵌合させる溝180L、18 0Rを形成した場合を例示する。

【0063】

図8に示す実施形態では、基板側コンポーネント140が基板102に取り付けられる と、上記一対の細長の矩形スタッド148L,148Rが、基板102上の一対の溝18 0L,180Rに嵌めこまれる。矩形スタッド148は、その側面が溝180の対応する 側面で受け止められ、矩形スタッド148の底面が、溝180の底面にある下部クラッド 30

10

30

40

層160の上面に当接する。これにより、導波路側マイクロレンズアレイ152が、対応 する導波路の反射面に、水平方向および垂直方向で位置合わせされる。特に図8(C)お よび図8(D)で示す実施形態では、溝180L,180Rがコア材料を用いて導波路の コアと同時に形成されているので、第1の実施形態と同様に、高い加工寸法の精度および 導波路のコアと高い位置合わせ精度で形成できる。

【0064】

図9(A)に示す実施形態では、合計4つのL字型のダミーコア170LT,170L B,170RT,170RBが形成されている。合計4つのL字型のダミーコア170は、一対の矩形スタッド148L,148Rそれぞれにおける2箇所の外側の4つの角を受け止めている。図9(B)に示す実施形態では、一対の矩形スタッド148における対向する側面以外の側面を受け止めるように、一対のコの字型のダミーコア170が形成されている。図9(C)に示す実施形態では、一対の矩形スタッド148それぞれにおける内側の4つの角を受け止めるように一対のL字型のダミーコア170L,170Rが形成されている。

【 0 0 6 5 】

上述したように、一対の矩形スタッド148の基板水平方向の移動の自由度を制限する ように導波路層110に一揃いの位置決め部材を形成することで、基板102に対し基板 側コンポーネント140を良好に設置することができるようになる。

【0066】

以下、図2(B)および図10を参照しながら、4列にレンズが配列されたマイクロレ ²⁰ ンズアレイを用いる場合の接続構造について説明する。図2(B)は、4列にレンズが配 列されたマイクロレンズアレイを用いる場合の導波路の上面図を示し、図10は、4列に レンズが配列された基板側コンポーネント140の上面図を示す。

【 0 0 6 7 】

図2(B)に示す実施形態では、反射面Mは、導波路の配列において4つの導波路を単位として、隣接する導波路間で位置をずらして形成されており、4列に構成されている。 図10に示す基板側コンポーネント140は、上述した反射面Mの2次元配列に対応して 4列にレンズ144がスタガ配列されたマイクロレンズアレイ142を備える。これに対応して、ファイバ・コネクタ150においても、上述した反射面Mの2次元配列に対応し て4列にマイクロレンズ154がスタガ配列されたマイクロレンズアレイ152を備えら れることになる。

【0068】

図2(A)~図9および図2(B)および図10を参照して説明したように、スタガ型 に反射面およびマイクロレンズの配列数を増やすことによって、導波路のピッチ間隔を光 ファイバのピッチ間隔を列数で割った長さまで、また好ましくはファイバ外径よりも小さ いサイズまで、狭小化することが可能となる。

【0069】

以下、図11~図15を参照しながら、本発明の第1の実施形態による光コネクタ・ア センブリ132を基板102に固定する固定方法について説明する。 【0070】

図11は、光コネクタ・アセンブリ132を基板102に固定する簡易な固定方法を示 す。上述したように基板102の導波路層110には、上部クラッド層166には、下部 クラッド層160およびダミーコア170L,170Rを露出させる溝172L,172 Rが形成されている。図11に示す固定方法では、まず、この溝172L,172Rの矩 形スタッド148が配置される箇所174L,174R周辺に光硬化性接着剤190を塗 布する。光コネクタ・アセンブリ132のうちの少なくとも基板側コンポーネント140 は、光硬化性接着剤を硬化させる特定波長に対し光透過性を有する材料で形成されている

[0071]

基板側コンポーネント140を導波路層110上に設置した後、上方から基板側コンポ ⁵⁰

ーネント140を通して硬化用の光を照射し、光硬化性接着剤190を硬化する。これにより、光コネクタ・アセンブリ132を構成する基板側コンポーネント140を基板102に固定する。その後は、光ファイバ・リボン130が固定されたファイバ・コネクタ150を、基板側コンポーネント140に嵌めこめば、光接続が完成する。
【0072】

図12は、光コネクタ・アセンブリ132を基板102に固定する改良された固定方法 を示す。図12に示す改良された固定方法では、基板102上の導波路層110の上部ク ラッド層166の表面における反射面Mの配列176を挟んだ箇所にリセス192が形成 される。

【0073】

上記リセス192は、導波路層110の上部クラッド層166の表面を浅く切削加工す ることによって形成することができる。あるいは、導波路層110の上部クラッド層16 6を成形する際に、図13(A)および図13(B)に示すような2つのマスクを用いて 2層でパターニングすることで形成してもよい。図13(A)に示す第1のマスクパター ンは、溝172を画定し、第2のマスクパターンは、溝172およびリセス192の両方 を画定するものである。

【0074】

図12に示す改良された固定方法では、基板側コンポーネント140を基板102上に 配置した後、破線190で示すように、溝172の部分を含む導波路層110の表面に光 硬化性接着剤を塗布する。このとき、リセス192は、導波路層110の表面に塗布され た接着剤が、導波路層110中に形成された45°マイクロミラーの空間に流入してしま うことを防止するはたらきをする。

【0075】

図12に示す固定方法では、図11に示した溝172の部分にのみ接着剤を塗布する場合に比較して、より大きな接着面積を確保することができ、光ファイバ・リボン130にかかる引っ張り力に対する耐性を向上させることができる。また、有機材料の基板102 上に形成された導波路層110と、基板側コンポーネント140との間には、通常、熱膨 張係数に差がある。図12に示すように、導波路層110の表面で基板側コンポーネント 140の底面と広く接着させることにより、熱膨張係数の差に起因した熱ずれを好適に防 止することができる。

【0076】

図14は、光コネクタ・アセンブリ132を構成するファイバ・コネクタ150を基板 102に固定する固定治具300を示す。図14(A)は、基板102の上面図を示し、 図14(B)は、基板102、光コネクタ・アセンブリ132および固定治具300の側 面図を示す。なお、図14(B)は、概ね光ファイバ・リボン130が挿入される開口部 302の中央で切断した断面図を表しているが、中央の前後に設けられる固定治具300 の締結穴304,308および締結部材306などが模式的に図示されている点に留意さ れたい。

[0077]

図14に示す固定治具300は、光コネクタ・アセンブリ132毎のファイバ・リボン 40 130が挿入される開口部302と、ねじなどの締結部材を挿通する締結穴304を有す る。固定治具300の開口部302は、光ファイバ・リボン130を挿通し、ねじなどの 締結部材306を、締結穴304を通して基板102側の締結穴308に螺合させること で、基板102上面と、固定治具300の下面との間に光コネクタ・アセンブリ132を 挟み込み固定する。

【0078】

図15は、光コネクタ・アセンブリ132を構成するファイバ・コネクタ150を基板 102に固定する他の固定治具300を示す。図15は、基板102、光コネクタ・アセ ンブリ132および固定治具300の斜視図を示している。

[0079]

10

図15に示す固定治具300は、図14に示したものと同様に、光コネクタ・アセンブ リ132毎の光ファイバ・リボン130が挿入される開口部302および締結穴304を 有する。固定治具300に設けられた開口部302は、少なくともファイバ・コネクタ1 50を挿通する寸法を有しており、開口部302の周辺には、開口部302の一部を開閉 するストッパ300aが設けられている。ファイバ・コネクタ150を開口部302に挿 通した後、ストッパ300aを倒し、開口部302の一部を閉じることにより、固定治具 300から光ファイバ・リボン130が抜けないようになる。

(15)

[0080]

図15に示す固定治具300も光ファイバ・リボン130を挿通し、締結部材306を 、締結穴304を通して基板102側の締結穴308に螺合させることで、基板102上 面と、固定治具300の下面との間に光コネクタ・アセンブリ132を挟み込み固定する ことができる。

[0081]

図14または図15に示した固定治具300を用いることにより、図11~図13に示 した接着剤のみで固定する場合に比較して、光ファイバ・リボン130にかかる引っ張り 力に対する耐性をさらに向上させることができる。

[0082]

[第2の実施形態]

上述した第1の実施形態による光コネクタ・アセンブリ132は、基板側コンポーネン ト140およびファイバ・コネクタ150の2部品で構成されていた。そして、一体形成 20 された部品である基板側コンポーネント140において、ファイバ・コネクタ150と結 合する結合部として、穴または溝146が設けられていた。すなわち、第1の実施形態に よる基板側コンポーネント140は、導波路側マイクロレンズアレイ142を備えるレン ズアレイ部の役割を有するとともに、ファイバ・コネクタ150を支持するホルダ部の役 割を有する。

[0083]

以下、ファイバ・コネクタ450を支持するファイバ・ホルダ460が、マイクロレン ズアレイを備えるレンズアレイ440とは独立した部品として構成される、第2の実施形 態について、図16および図17を参照して説明する。なお、図16および図17は、導 波路層の反射面Mが4列を構成し、マイクロレンズアレイもこれに対応して4列を構成す る実施形態を説明する。

[0084]

図16および図17は、本発明の第2の実施形態による光MCM400と光ファイバ・ リボン430との間の接続構造を模式的に示す図である。図16(A)は、導波路の軸方 向に対して側方から見た側面図を示し、図16(B)は、導波路の軸方向から見た側面図 を示す。図17(A)は、レンズアレイ440の上面図を示し、図17(C)は、基板4 02の上面図を示す。図17(B)は、レンズアレイ440および基板402の導波路の 軸方向から見た側面図を示し、概ねレンズアレイ440および基板402を位置合わせ部 材の中央で切断した断面図を表しているが、中央の前後に設けられるマイクロレンズが模 式的に図示されている点に留意されたい。また、図17(A)には、点線で、レンズアレ イ440の底面に設けられるピン444L,444Rが示されている。

[0085]

第2の実施形態においても、第1の実施形態と同様に、導波路層110の導波路412 各々の端部に、45。傾斜の反射面418が形成され、基板402上の反射面418の位 置に、第2の実施形態による光コネクタ・アセンブリ432が配置される。

[0086]

本発明の第2の実施形態による光コネクタ・アセンブリ432は、導波路側マイクロレ ンズアレイ442を備えるレンズアレイ440と、ファイバ側マイクロレンズアレイ45 2を備えるファイバ・コネクタ450と、さらに、レンズアレイ440およびファイバ・ コネクタ450を収容するファイバ・ホルダ460とを含み構成される。

10



[0087]

レンズアレイ440は、これに付属するマイクロレンズアレイ452のマイクロレンズ 各々が導波路各々に形成された反射面418各々に位置合わせされるように基板102上 に位置決め設置される。

(16)

[0088]

本発明の第2の実施形態によるレンズアレイ440および基板402は、上記位置合わ せするための位置合わせ機構をさらに含み構成される。説明する実施形態では、図16(B)および図17に示すように、レンズアレイ440の位置合わせ機構を構成する部分と しては、底面における導波路側マイクロレンズアレイ442に対応する領域の両側に、一 対のテーパ形状を有する突起部(ピン)444L,444Rが形成されている。これに対 応して、基板402の導波路層410においては、上記ピン444L,444Rが挿入さ れる一対の溝416L.416Rが基板402に設けられている。 [0089]

10

溝416は、フォトリソグラフィ時のパターン形成、または導波路層410を形成した

後のレーザ加工により導波路層に設けられる。ピン444L,444Rがテーパ形状を有 することにより、簡便に精度高く、レンズアレイ440を導波路層410上の適切な位置 420に位置決めすることが可能となる。レンズアレイ440は、導波路層410に接着 剤などで固定される。

[0090]

20 ファイバ・ホルダ460には、上部にファイバ・コネクタ450を収容する上部開口部 460aが設けられ、下部にレンズアレイ440を収容する下部開口部460bが設けら れている。上部開口部460aおよび下部開口部460bは、ファイバ・コネクタ450 およびレンズアレイ440を収容したときに、ファイバ側マイクロレンズアレイ452の レンズ各々が、対応する導波路側側マイクロレンズアレイ442に位置合わせされるよう に互いの位置を定めて形成される。

[0091]

下部開口部460bは、レンズアレイ440を若干の隙間をもって内包できる寸法で形 成される。ファイバ・ホルダ460が基板402上に設置されると、下部開口部460b に、基板402に位置決めされたレンズアレイ440が収容される。ファイバ・ホルダ4 60は、貫通ピン462などにより、基板402に固定される。

[0092]

上部開口部460aも、余裕をもってファイバ・コネクタ450を収容できる寸法を有 している。ファイバ・コネクタ150は、上部開口部460aのくぼみ中に挿入され、こ れにより、ファイバ側マイクロレンズアレイ452各々が導波路側マイクロレンズアレイ 4 4 2 のマイクロレンズ各々に位置合わせされる。上部開口部 4 6 0 a のくぼみにおける ファイバ・コネクタ450に当接する底面は、ファイバ側マイクロレンズアレイ452の レンズ各々が、下部開口部460bに収容される導波路側マイクロレンズアレイ442の レンズ各々と平行を維持できるように形成される。

[0093]

上部開口部460aには、図16(B)に示すように、ファイバ・コネクタ450を上 方から挿入しやすくするようなテーパ460cが形成されている。上部開口部460aに 収容されたファイバ・コネクタ450は、個々の基板402上のファイバ・ホルダ460 に、板ばね状のクリップなどのラッチ・リリース機構470を用いて固定される。 [0094]

以上説明した実施形態によれば、基板上面で上方から光ファイバを接続する構成とする ことで、基板側面で接続する場合と比較した空間的な制約が緩和される。同時に、双方の マイクロレンズアレイを介して導波路および光ファイバ間を結合する構成とすることで、 導波路および光ファイバ間の位置合わせ公差が緩和される。導波路および光ファイバ間の 位置合わせの公差は、典型的には、導波路および光ファイバを直接位置合わせする場合と 比較して、10倍程度まで好適に緩和される。例えば、0.5dB以下の損失を目標とし 30

た場合、上記位置合わせ公差は、従来では数 μ m まで要求されるが、本発明の実施形態に よる構成では、数十 μ m 程度まで緩和することができる。 【 0 0 9 5 】

また、従来技術では、光ファイバのピッチ間隔が定まっているため、導波路を狭小化す ることができず、光コネクタ自体を小型化することが難しかった。これに対して、上述し た構成を採用することで、光コネクタ・アセンブリ自体のサイズを小型化することができ 、同一実装面積上に、より多数の光コネクタ・アセンブリを配置して、多チャンネル化お よび高バンド幅化を図ることが可能となる。実装基板上で多チャンネルの光信号の入出力 部が半導体回路チップに対し近接して設けた光MCMを作成することができるので、ます ます高まる光インターコネクトにおける消費電力の削減および高速化に対する要求に応え ることができる。

【0096】

以上説明したように、本発明の実施形態によれば、基板上に形成された複数の導波路を 外部の光伝送路に対し接続する光接続構造の空間的制約を緩和し、位置合わせ公差を緩和 することができる、光デバイス、光コネクタ・アセンブリおよび光接続方法を提供するこ とができる。

【 0 0 9 7 】

これまで本発明を、特定の実施形態をもって説明してきたが、本発明は、上述までの実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、変更、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。

20

10

【符号の説明】 【0098】

100,400,500...光MCM、102,200,402,502...基板、104... 電気入出力部、106,502...電気配線、110,410,510...導波路層、112, ,118,418,512...反射面、114,514...ビア、116,516...アンダー フィル、120,520...半導体チップ、122,522...TIA/LIA、124,5 24...LDD、126,526...PD、128,528...VCSEL、130,430, 530...光ファイバ、132,432...光コネクタ・アセンブリ、140...基板側コンポ ーネント、142,152,442,452...マイクロレンズアレイ、144,154... マイクロレンズ、146...穴または溝、148...矩形スタッド、150,450...ファイ バ・コネクタ、156...棒状スタッド、160,202...下部クラッド層、164...コア 、166,206...上部クラッド層、168,412...導波路の配列、170,214... ダミーコア、172,180...溝、190...光硬化性接着剤、192...リセス、204... コア層、212...溝、300...固定治具、302...開口部、304,306...締結穴、3 06...締結部材、溝...416、440...レンズアレイ、444...ピン444、460...フ ァイバ・ホルダ、462...貫通ピン、470...ラッチ・リリース機構











【図4】



【図5】

【図6】





【図7】



【図8】









【図11】







【図13】

【図14】









【図15】

【図16】











フロントページの続き

- (74)代理人 100112690 弁理士 太佐 種一
- (72)発明者 沼田 英俊
 東京都江東区豊洲五丁目6番52号 NBF豊洲キャナルフロント 日本アイ・ビー・エム株式会
 社東京基礎研究所内
- (72)発明者 中川 茂
 東京都江東区豊洲五丁目6番52号 NBF豊洲キャナルフロント 日本アイ・ビー・エム株式会
 社 東京基礎研究所内
- (72)発明者 平 洋一
 東京都江東区豊洲五丁目6番52号 NBF豊洲キャナルフロント 日本アイ・ビー・エム株式会
 社 東京基礎研究所内

審査官 廣崎 拓登

```
(56)参考文献 特表2008-502013(JP,A)
特開2013-020027(JP,A)
米国特許第07421160(US,B1)
国際公開第2010/098171(WO,A1)
米国特許第06973248(US,B1)
国際公開第2012/023430(WO,A1)
特開2008-216905(JP,A)
特開2014-085415(JP,A)
特開2015-114431(JP,A)
```

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 0 2 B	6/12 -	6/24
	6/255-	6/27
	6/30 -	6/34
	6/36 -	6/43